PARENT ABSTRACTS OF JANN

(11)Publication number:

10-308040

(43)Date of publication of application: 17.11.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/26

(21)Application number: 09-130509

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

02.05.1997

(72)Inventor: SHIBATA KIYOTO

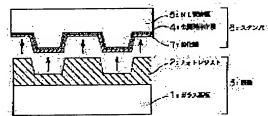
AMAN YASUTOMO

(54) OPTICAL DISK STAMPER AND ITS PRODUCTION

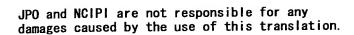
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a stamper for molding optical disks having a good releasing property from molded goods, a process for producing the same and an optical disk.

SOLUTION: A photoresist film 2 is applied and formed on a glass substrate 1 and is subjected to stages for laser exposure, development, etc., by which a master optical disk 3 having rugged patterns on this photoresist film 2 is obtd. Conducting films having at least a two-layered structure consisting of an oxidized film 7 and a metallic conducting film 4 adjacent thereto are formed on the surface of this master disk 3, by which the stamper 6 for molding the optical disks by electroforming is obtd. A releasing layer consisting of an org. fluorine compd. is formed via a siloxane bond on this oxidized film 7 after the stamper 6 is peeled from the master disk 3.



* NOTICES *



1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.*** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] the micro components characterized by consisting of a super-elasticity metal with which hard anodic oxidation coatings were formed in the front face — public funds — a mold. [Claim 2] the micro component according to claim 1 characterized by said hard anodic oxidation coatings having an inclination distribution presentation — public funds — a mold. [Claim 3] the micro component according to claim 1 which said hard anodic oxidation coatings consist of TiN, and said TiN concentration is falling toward the interior from the surface of said hard anodic oxidation coatings, and are characterized by said super-elasticity metal consisting of a Ti alloy — public funds — a mold.

[Claim 4] said Ti alloy — aluminum:4 to 5%, V:2.5 to 3.5%, Fe:1.5 to 2.5%, Mo:1.5 to 2.5% (above, Mass%), and remainder: — the micro component according to claim 3 characterized by consisting of Ti substantially — public funds — a mold.

[Claim 5] the micro component according to claim 1 which said hard anodic oxidation coatings consist of aluminum 2O3, and said 2Oaluminum3 concentration is falling toward the interior from the surface of said hard anodic oxidation coatings, and are characterized by said superelasticity metal consisting of an aluminum alloy — public funds — a mold.

[Claim 6] processing the front face of a substrate — micro components — public funds — the micro components characterized by imprinting said pattern through said coat to said super—elasticity metal by preparing the pattern of a mold, and forming in the front face of said pattern the hard anodic oxidation coatings which prevent a reaction with said substrate subsequently, and carrying out diffused junction of a super—elasticity metal and said coat — public funds — the manufacture approach of a mold.

[Claim 7] the micro component according to claim 6 characterized by turning and reducing the concentration of the hard morphogenetic substance of said hard anodic oxidation coatings to a super-elasticity metal side from said substrate front face — public funds — the manufacture approach of a mold.

[Claim 8] the micro component according to claim 7 characterized by said hard morphogenetic substance consisting of TiN by said substrate's consisting of Si and said super-elasticity alloy consisting of a Ti alloy — public funds — the manufacture approach of a mold.

[Claim 9] the micro component according to claim 7 characterized by said hard morphogenetic substance consisting of aluminum 203 by said substrate's consisting of Si and said super-elasticity alloy consisting of an aluminum alloy — public funds — the manufacture approach of a mold.

[Claim 10] the micro components of any one publication in claims 6-9 characterized by preparing said pattern by forming the resist pattern of said pattern in the front face of said substrate by the photolithography method, and removing the surface part of said substrates other than said resist pattern in the predetermined depth by etching — public funds — the manufacture approach of a mold.

[Claim 11] said Ti alloy — aluminum:4 to 5%, V:2.5 to 3.5%, Fe:1.5 to 2.5%, Mo:1.5 to 2.5% (above, Mass%), and remainder: — the micro component according to claim 8 or 10 characterized by consisting of Ti substantially — public funds — the manufacture approach

of a mold.

[Translation done.]

* NOTICES *



JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] a high precision with a manufacturing cost cheap [this invention] and — having — micro components with a surface degree of hardness high moreover — public funds — it is related with a mold and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] As micro components, there are the following, for example. [0003] (1) the spectrum in which the diffraction grating was formed — as shown in device drawing 10, it is the device which carries out the spectrum of the light wave length who fulfills predetermined diffraction conditions by forming a diffraction grating in a plane in a detailed pitch, and irradiating light at this.

[0004] (2) As shown in scale <u>drawing 11</u> for encoders, it is the plane scale with which detailed irregularity was formed.

[0005] (3) Form the slot which had a pitch on the full NERURENZU flat surface in the shape of a lens, and take out the light from a flat surface in the direction perpendicular to a flat

surface.

[0006] (4) Form the aggregate of a detailed lens on a micro-lens flat-surface substrate, package alignment on optics is enabled, and manufacture of a compound eye lens is also possible.

[0007] Conventionally, the above-mentioned micro components were manufactured patterning and by etching at the FOTORISO process to carrying out direct cutting of the product itself

by machining or glass, or silicon.

[0008] however, the above — a spectrum — since a processing machine very highly precise in order to machine a diffraction grating, and a processing control technique were needed in the case of a device and processing took long duration, cost was high. The same of this problem was said of micro components besides the above.

[0009] as the other manufacture approaches — micro components — public funds — there was also the approach of using a mold. There were the following in the manufacture approach of this metal mold.

(1) The approach (2) LIGA process which carries out direct cutting of the product metal mold itself by machining (Lithographie Galvanoformung Abfprmung)

(3) Electric spark forming [0010]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, there were the following problems in each above-mentioned manufacture approach.

[0011] In order that the approach by machining of (1) might have a problem in process tolerance and might acquire sufficient process tolerance, the high rigid large-sized machine was required for it. Therefore, the metal mold manufacturing cost was high.

[0012] LIGA of (2) forms a thick resist, and uses for and carries out patterning of the synchrotron orbital radiation on it, and although electroplating (electroforming) copies that resist pattern and it is manufactured, this approach needs the special and expensive facility which irradiates synchrotron orbital radiation. Moreover, product metal mold is electroplated for example, restricted to comparatively soft ingredients, such as gold and nickel.

[0013] electric spark forming of (3) -- for example, WEDG -- although it is the approach of

processing metal mold us the electrode prepared by the approach alled law, consumption of an electrode is a fundamental technical problem, by processing thoughout ong duration, this approach must exchange electrodes frequently and precision cannot come out of it easily. Moreover, when electrodes are exchanged, a huge amount of metal mold manufacturing costs require. Furthermore, surface roughness of an electron discharge method is coarse because of thermoforming.

[0014] therefore, a high precision with a manufacturing cost cheap [the purpose of this invention] and — having — micro components with a surface degree of hardness high moreover — public funds — it is in offering a mold and its manufacture approach. [0015]

[Means for Solving the Problem] That **** should be attained, this invention person etc. acquired the following knowledge, as a result of repeating research wholeheartedly. [0016] (1) substrates, such as Si, — the etching methods, such as the photolithography method and ion irradiation, — processing it — micro components — public funds — if this pattern is imprinted into Ti alloy as a material for metal mold which prepares the pattern of a mold and has super-elasticity etc. — micro components — public funds — the knowledge that a mold could be manufactured cheaply and with high precision was acquired. [0017] (2) However, in order to have performed the imprint of still more detailed irregularity, and the imprint of the sharp corner, it turned out only by pushing of superplastic materials that a limitation is in imprint precision. In order to solve this, by making into one the film and superplastic materials which were made to generate the film on the front face of Si mold, and pushed in and generated superplastic materials after that by the spatter etc. on it on the occasion of the above—mentioned imprint showed that the imprint of an overly detailed mold was possible.

[0018] (3) Although it is possible to form in the front face of the pattern made from Si SiO2 which has the generation inhibition function of said intermetallic compound beforehand, and the SiN film in order to prevent generation of the intermetallic compound of Ti alloy and Si on the occasion of the imprint of the above (1) If TiN concentration differs in an inclination distribution presentation, i.e., the depth direction, a surface part forms the TiN film in the front face of the pattern made from Si so that it may become unalloyed ti substantially, and Ti alloy is pushed in after that before an imprint It is highly precise and the imprint of the fine structure is attained, and moreover, since Ti alloy and unalloyed ti are excellent in diffused–junction nature, they join Ti alloy and the TiN film firmly by diffused junction. Consequently, the metal mold made from Ti alloy with which the TiN film of a high degree of hardness was formed in the front face and which can be equal to processing of repeat use, extrusion molding, etc. is obtained. And since superplasticity forming conditions and diffused–junction conditions overlapped, the knowledge that an imprint and diffused junction could carry out at one process was acquired.

[0019] In addition, the above-mentioned super-elasticity is a phenomenon which a metallic material is narrow under a certain conditions (necking), and occasionally produces the huge elongation of ** 1000% hundreds of % to 1000% nothing. Therefore, if a super-elasticity phenomenon is made to discover by adding plastic working in a certain specific temperature region, as a result of entering to the details in a metallic material fang furrow, manufacture of a replica faithful to a pattern is attained. The term of the gestalt of implementation of invention explains the metallic material which has super-elasticity.

[0020] This invention is made based on the above-mentioned knowledge, and is characterized by the following.

[0021] Invention according to claim 1 has the description to consist of a super-elasticity metal with which hard anodic oxidation coatings were formed in the front face.

[0022] Invention according to claim 2 has the description for said hard anodic oxidation coatings to have an inclination distribution presentation.

[0023] In invention according to claim 3, said hard anodic oxidation coatings consist of TiN, said TiN concentration is falling toward the interior from the surface of said hard anodic oxidation coatings, and said super-elasticity metal has the description to consist of a Ti alloy.

[0024] invention according to claim 4 -- said Ti alloy -- aluminum 5%, V:2.5 to 3.5%, Fe:1.5 to 2.5%, Mo:1.5 to 2.5% (above, Mass%), and remainder: -- it has the scription to consist of Ti substantially.

[0025] In invention according to claim 5, said hard anodic oxidation coatings consist of aluminum 203, said 20aluminum3 concentration is falling toward the interior from the surface of said hard anodic oxidation coatings, and said super-elasticity metal has the description to consist of an aluminum alloy.

[0026] invention according to claim 6 processes the front face of a substrate — micro components — public funds — it has the description by preparing the pattern of a mold and subsequently forming in the front face of said pattern the hard anodic oxidation coatings which prevent a reaction with said substrate to imprint said pattern through said coat to said super—elasticity metal by carrying out diffused junction of a super—elasticity metal and said coat.

[0027] Invention according to claim 7 has the description to turn and reduce the concentration of the hard morphogenetic substance of said hard anodic oxidation coatings to a super-elasticity metal side from said substrate front face.

[0028] In invention according to claim 8, said substrate consists of Si, said super-elasticity alloy consists of a Ti alloy, and it has the description for said hard morphogenetic substance to consist of TiN.

[0029] In invention according to claim 9, said substrate consists of Si, said super-elasticity alloy consists of an aluminum alloy, and it has the description for said hard morphogenetic substance to consist of aluminum 203.

[0030] Invention according to claim 10 has the description by forming the resist pattern of said pattern in the front face of said substrate by the photolithography method to prepare said pattern by removing the surface part of said substrates other than said resist pattern in the predetermined depth by etching.

[0031] invention according to claim 11 — said Ti alloy — aluminum:4 to 5%, V:2.5 to 3.5%, Fe:1.5 to 2.5%, Mo:1.5 to 2.5% (above, Mass%), and remainder: — it has the description to consist of Ti substantially.

[0032]

[Embodiment of the Invention] next, the micro components by this invention — public funds — one embodiment of the manufacture approach of a mold is explained, referring to a drawing. [0033] The sectional view and drawing 2 which, as for drawing 1, show Si substrate with which the photoresist was applied The sectional view and drawing 4 which show a development process the sectional view showing an exposure process, and drawing 3 R> 3. The sectional view in which the sectional view showing an etching process and drawing 5 show the formation process of the TiN film to a prototypal front face, and drawing 6 the micro components with which the sectional view showing an imprint process and drawing 7 R> 7 were manufactured by this invention — public funds — the sectional view in which the sectional view showing a mold and drawing 8 show an injection—molding process, and drawing 9 R> 9 are the explanatory views of diffused junction.

[0034] as the metal which has super-elasticity — Ti alloy, aluminum alloy, Cu alloy, Mg alloy, etc. — it is — the inside of it — micro components — public funds — although especially Ti alloy or aluminum alloy excellent in corrosion resistance is desirable since it may be exposed to a corrosive liquid and gas in case it is used as a mold, you may be the metal which has the super-elasticity besides the above other than this.

[0035] As an ingredient in which super-elasticity is shown with Ti alloy, although there is Ti-6aluminum-4V alloy, working temperature is 875 to 950 degrees C, and an elevated temperature, and there is much constraint on a facility. For example, there is constraint with the life of a fixture the expensive processing fixture which has the high temperature strength which can be equal to hot working is required, and short.

[0036] On the other hand, a Ti-4.5aluminum-3V-2Fe-2Mo alloy shows super-elasticity at the temperature of about 700 degrees C, and a facility top also tends to be used for it. Moreover, the maximum elongation of this alloy is also suitable for manufacture of more precise

components very highly therefore compared with extent and other redients in 2000%. Specifically, plastic workless performed into an inert gas ambient mosphere with the strain rate of 10-5S-1 to 10-2S-1 within the limits in the temperature requirement of (-50 degrees C of (-200 degrees C of beta transformation points) to beta transformation points of this alloy).

[0037] the above-mentioned Ti alloy — using it — micro components — public funds — in order to manufacture a mold, as shown in <u>drawing 1</u>, a photoresist 2 is first applied to predetermined thickness on the front face of the Si substrate 1.

[0038] Subsequently, as shown in <u>drawing 2</u>, light is irradiated on the front face of the Si substrate 1 through a mask 3, and a mask pattern is imprinted to a photoresist 2.

[0039] Next, as shown in $\frac{\text{drawing }3}{\text{drawing }3}$, a solvent removes photoresist 2A of a part which light

[0040] Next, as shown in $\frac{drawing 4}{drawing 4}$, the front face of the Si substrate 1 is etched into the predetermined depth by dry etching, such as ion irradiation, and the slot 4 on the resist pattern is formed in the front face of the Si substrate 1.

[0041] Although the width of face (W) of the above-mentioned slot 4 changes with applications, it is within the limits of 200 micrometers from 50nm. Although the wet etching by the solvent is sufficient as the etching method, it can perform etching with the highly precise dry etching.

[0042] next, as shown in <u>drawing 5</u>, the photoresist 2 which remains is removed and the TiN film 5 is vapor—deposited in predetermined thickness by sputtering to a front face — making — micro components — public funds — the pattern 6 of a mold is prepared. As shown in <u>drawing 9</u>, sputtering conditions are adjusted, and the TiN film 5 forms the front face which touches said titanium alloy by TiN concentration becoming low toward the surface of the side which touches the titanium alloy mentioned later so that it may become the inclination distribution presentation which serves as unalloyed ti substantially.

[0043] Next, as shown in drawing 6, the pattern 6 by which the TiN film 5 was formed in the front face is put on a pedestal 7, and the titanium alloy (V-2% Fe-2%Mo of Ti-4.5%aluminum-3%) 8 as a material for metal mold is put on a pattern 6. And it pressurizes heating a titanium alloy 8 at a heater 9, and a pattern 6 is imprinted through the TiN film 5 to a titanium alloy 8. As mentioned above, when the titanium alloy 8 of the above-mentioned presentation is heated at about 700 degrees C, super-elasticity appears and it shows unique stretch. consequently - since a titanium alloy 8 enters to details in the slot 4 of a pattern 6 — a replica faithful to a pattern 6, i.e., the micro components made from a titanium alloy, — public funds — a mold 10 is manufactured.

[0044] In addition, since Ti alloy and unalloyed ti are excellent in diffused-junction nature on the occasion of the above-mentioned imprint, as shown in <u>drawing 9</u>, Ti alloy and the TiN film are firmly joined by diffused junction. Consequently, the metal mold 10 made from Ti alloy with which the TiN film 5 of a high degree of hardness was formed in the front face and which can be equal to processing of repeat use, extrusion molding, etc. is manufactured. And since superplasticity forming conditions and diffused-junction conditions overlap, an imprint and diffused junction can perform them at one process. Furthermore, since metal mold materials, such as Ti alloy, are pushed in after making the hard TiN film and 20aluminum3 film form in a substrate, it is more highly precise and the imprint of the fine structure of nm order is attained.

[0045] If the metal mold 10 with which the TiN film 5 of a high degree of hardness was formed in the front face is set in the extrusion-molding mold 11 and injection molding of the plastics is carried out as shown in <u>drawing 8</u> in order to use this metal mold 10 and to manufacture the micro components made from plastics, as shown in this drawing, the micro components 12 with which slot 12A of the above-mentioned width-of-face (W) dimension was formed can be fabricated.

[0046] Although the above is the case where the titanium alloy which has super-elasticity as a material for metal mold is used, in, using aluminum alloy which has super-elasticity for example, it forms 2Oaluminum3 film in the front face of a pattern 6. under the present

circumstances, the case are Ti alloy which have super-elasticity use when form so that the oxidation conditions of auminum might be adjusted, 20 aluminum concentration might become low toward a surface and a surface might serve as an inclination distribution presentation which serve as pure aluminum substantially and precision with a manufacturing cost, cheaply high almost similarly — have — micro components with a surface degree of hardness high moreover — public funds — a mold can be manufacture.

[0047]

[Effect of the Invention] The pattern of a mold is prepared. as mentioned above, the thing for which the front face of substrates, such as Si, is processed by the photolithography method, the dry etching method, etc. according to this invention — micro components — public funds — subsequently On the front face of said pattern, by imprinting said pattern to metals, such as a titanium alloy which has super—elasticity, by forming hard film, such as TiN which has an inclination distribution presentation, in the depth direction precision with a cheaply high manufacturing cost — having — a spectrum with a surface degree of hardness high moreover — micro components, such as a device and a scale for encoders, — public funds — a mold — easy — it can manufacture — ******** — useful effectiveness is brought about.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-308040

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

G11B 7/26 511

G11B 7/26

511

審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平9-130509

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

(22)出願日

平成9年(1997)5月2日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 柴田 清人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 阿萬 康知

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

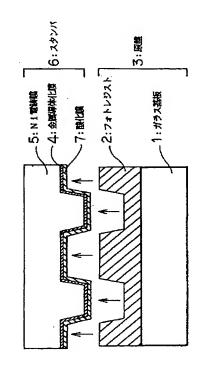
会社リコー内 .

(54) [発明の名称] 光ディスクスタンパ及びその製造方法

(57)【要約】

[課題] 成型品との離型性が良好な光ディスク成型用スタンパとその製造方法ならびに光ディスクを提供する。

【解決手段】 ガラス基板1上にフォトレジスト膜2を塗布形成し、レーザ露光、現像等の工程を経てフォトレジスト膜2上に凹凸パターンを有した光ディスク原盤3を得、との原盤3の表面に酸化膜7とこれに隣接する金属導体化膜4の少なくとも2層構造の導体化膜を形成し、電鋳によって光ディスク成形用スタンパ6を得、原盤3からスタンパ6を剥離後に、酸化膜7上に有機フッ素化合物からなる離型層をシロキサン結合を介して形成させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス基板上にフォトレジスト膜を塗布 形成し、レーザ露光、現像等の工程を経てフォトレジス ト膜上に微細な凹凸パターンを有した光ディスク原盤を 得て、次に該光ディスク原盤の表面に導体化膜を形成 し、該導体化膜を陰極として電鋳することによって光デ ィスク成形用スタンバを得るスタンパの製造方法におい て、

前記導体化膜を酸化膜とこれに隣接する金属導体化膜の 少なくとも2層構造とし、さらに前記原盤からスタンパ 10 を剥離した後に、該酸化膜上に有機フッ素化合物からな る離型層をシロキサン結合を介して形成することを特徴 とする光ディスクスタンパの製造方法。

【請求項2】 前記導体化膜を構成する前記酸化膜の膜 厚を少なくとも100nm以上とすることを特徴とする 請求項1記載の光ディスクスタンパの製造方法。

【請求項3】 前記導体化膜を形成する工程において、 前記酸化膜を構成する金属元素とこれに隣接する金属導 体化膜の金属元素とを同一の元素とし、さらに両者の界 面を傾斜組成とすることを特徴とする請求項1記載の光 20 ディスクスタンパの製造方法。

【請求項4】 前記導体化膜を形成する工程において、 前記酸化膜をCF、O、、隣接する金属導体化膜をCF とNiの2層構造とすることを特徴とする請求項1記載 の光ディスクスタンパの製造方法。

【請求項5】 前記有機フッ素化合物からなる離型層を 形成する工程において、水のイオンビーム照射によって 前記酸化膜表面を活性化した後に、有機フッ素化合物を 蒸着処理することを特徴とする請求項 1 記載の光ディス クスタンパの製造方法。

【請求項6】 前記導体化膜を構成する酸化膜がCェュ 〇、であって、前記酸化膜Cr、〇、の表面を加熱しな がらUV照射した後に、有機フッ素化合物を化学吸着処 理することを特徴とする請求項1記載の光ディスクスタ ンパの製造方法。

【請求項7】 前記酸化膜Cr、O,の表面を赤外線照 射により加熱することを特徴とする請求項6記載の光デ ィスクスタンパの製造方法。

【請求項8】 請求項6記載の光ディスクスタンパの製 程に用いる治具であって、スタンパを裏面と表面の外周 部とで支持し、スタンパ表面と前記外周部支持治具とで 形成される空間に有機フッ素化合物吸着処理液を供給し て、スタンパ表面のみに該有機フッ素化合物処理を行う 光ディスクスタンパの製造用治具。

【請求項9】 請求項1~7記載の製造方法により製造 されたことを特徴とする光ディスク成型用スタンパ。 【請求項10】 請求項9記載の光ディスク成型用スタ ンパを用いて製造されたことを特徴とする光ディスク。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、情報記録媒体の成 型用スタンパ及びその製造方法および情報記録媒体に関 し、とりわけ光ディスク成型用スタンパ及びその製造方 法および光ディスクに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、光ディスク成型用スタンパを製造 する方法としては、図5のように、ガラス基板1上にフ ォトレジスト膜2を塗布形成し、レーザ露光、現像等の 工程を経て、フォトレジスト膜上に微細な凹凸パターン を有した光ディスク原盤3を作成し、次にとの光ディス ク原盤3の表面にNi (ニッケル)等の金属導体化膜4 を形成し、これを陰極として電鋳してNi電鋳膜5を形 成したものを原盤3から剥離することによりスタンパ6 1を製造する方法が一般的である。光ディスクは、との ようにして得られたスタンパ61を射出成形金型に用い て製造される。

【0003】上記従来法において、光ディスクの成型時 にスタンパから樹脂成型品が良好に離型できないトラブ ルが発生していた。即ち、信号ピットや案内溝等の形状 が成型品に忠実に反転されなかったり、さらには信号ピ ットや案内溝の形状が崩れたり、他の信号部分にゴース ト状に重なって形成されたりして、正常に信号が読み書 きできない不良品が発生していた。この原因は、スタン バ表面に信号ピット等の微細な凹凸形状が多数存在する ため、樹脂がこの凹凸部に流れ込んだ時に一種の嵌合状 態となるためである。また、冷却によって成型品はスタ ンパ以上に収縮するため、結果的にこのような嵌合部間 で圧縮応力が働き、離型抵抗として作用することにな る。これらは主に物理的な作用によるものであるが、長 時間の成形によってスタンパ表面に樹脂の低分子組成物 等が徐々に付着し、これらが成型品と強固に密着しあう

[0004]一方、昨今においては情報の記録密度を上 げるため光ディスクの信号ピットや案内溝等の寸法がさ らに小さくなる傾向にある。例えば、大量のデジタル画 像を入出力するためのDVDの案内溝ピッチは0.76 μm (従来のCDでは1.2μm) である。 このような 光ディスクでは、スタンパと樹脂基板の微小な嵌合部が 造方法の有機フッ素化合物からなる離型層を形成する工 40 増加し、加えてスタンパと樹脂とが接する実質的な表面 積も増大するため、成型品に傷をつけないような良好な 離型がますます困難になりつつある。

ためという化学的な作用も考えられている。

【0005】そとで、前記のような離型不良を改善する 目的で、スタンパの表面に有機フッ素化合物等の分子膜 を離型層として形成する技術が開示されている。例え は、第一の改良技術として、特開平8-147769号 公報や特公平8-18336号公報には、フルオロアル キルシランSiCl。X, の化学吸着によって、表面 に-CF, 基を持つ単分子膜を配向させたプラスチック 50 成形金型が提案されている。

[0006]また、第二の改良技術として、主に離型層 である有機フッ素化合物をスタンパに強固に結合させる 目的で、スタンパ表面に酸化物を形成した後に、フルオ ロアルキルシランを吸着させた金型が、特開平6-10 3617号公報で開示されている。

[0007]

[発明が解決しようとする課題] 前記第一の改良技術で は、加水分解基にClを有するクロルシランはSiCl , X_{3-n}、アルコキシシランSi(OC_n H_{2n-1}), X ₃-。 よりも無機物表面との反応性が高く、より強固にか つ髙密度に分子膜を配向できるメリットがあるものの、 反応過程で塩酸HC 1を発生するため、一般の鉄系金型 には適応困難であるという問題があった。

【0008】一方、Niのような金属を主体とする金型 ではある程度の耐食性が期待できるが、スタンパの場 合、孔食によって信号ピットと同等サイズ以上の凹形状 が形成されても致命的な形状不良となってしまうため、 実際上スタンパへのクロルシランの適用は不可能であっ tc.

【0009】さらに、前記第二の改良技術では、スタン パのピット形状を大きく変化させないために、成膜する 酸化物の厚さは数10nmが限界と考えられる。このよ うな薄い酸化物の場合、膜は島状構造であるため力学的 には比較的脆く、成型時の射出圧力や溶融樹脂との接 触、それらに伴うスタンパの変形挙動等によって、スタ ンパのNi面と酸化物との界面からその上部に形成され たフッ素化合物離型層でと剥離してしまうという不具合 があった。即ち、有機フッ素化合物離型層が形成された 酸化物層の密着強度が不十分であるという欠点があっ

【0010】本発明は、前記のような従来技術における 問題点を解決するためなされたもので、成型品との離型 性が良好な光ディスク成型用スタンパとその製造方法な らびに光ディスクを提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため 本発明に係る光ディスクスタンパの製造方法は、ガラス 基板上にフォトレジスト膜を塗布形成し、レーザ露光、 現像等の工程を経てフォトレジスト膜上に微細な凹凸パ ターンを有した光ディスク原盤を得て、次に該光ディス ク原盤の表面に導体化膜を形成し、該導体化膜を陰極と して電鋳することによって光ディスク成形用スタンパを 得るスタンパの製造方法において、前記導体化膜を酸化 膜とこれに隣接する金属導体化膜の少なくとも2層構造 とし、さらに前記原盤からスタンパを剥離した後に、該 酸化膜上に有機フッ素化合物からなる離型層をシロキサ ン結合を介して形成することを特徴とする。

【0012】前記の構成によれば、アルコキシ基、クロ ル基、シアノ基、イソシアナト基、アミノ基等の官能基 Yを有するシラン系化合物が高密度かつ強固に化学吸着 50 スタンパ表面と前記外周部支持治具とで形成される空間

(共有結合)されて良好な離型層が形成される。しかも 酸化膜があらかじめ形成されているため、原盤のピット 形状に忠実な、良好な信号品質のスタンパの製造が可能 になる.

【0013】本発明に係る光ディスクスタンパの製造方 法は、前記導体化膜を構成する前記酸化膜の膜厚を少な くとも100nm以上とすることを特徴とする。前記の 構成によれば、膜厚が十分に厚いため、酸化膜構造が緻 密になるとともに密着性や機械的強度が改善され、さら にシラン化合物の吸着活性点が高密度で形成される。

[0014] 本発明に係る光ディスクスタンパの製造方 法は、前記導体化膜を形成する工程において、前記酸化 膜を構成する金属元素とこれに隣接する金属導体化膜の 金属元素とを同一の元素とし、さらに両者の界面を傾斜 組成とすることを特徴とする。前記の構成によれば、酸 化膜の密着力が高く、したがって境界部分からの脱落等 のない、耐久性が高いスタンパの製造が可能になる。

【0015】本発明に係る光ディスクスタンパの製造方 法は、前記導体化膜を形成する工程において、前記酸化 膜をCr、O、、隣接する金属導体化膜をCrとNiの 2層構造とすることを特徴とする。前記の構成によれ ば、2層構造のうちのCrが酸化膜Cr、O, と良好な 密着性を保ち、Niがその下層のCrとの良好な密着性 を有し、かつ酸化膜が残りにくいため、電鋳層との密着 性が改善されて耐久性が高いスタンパの製造が可能にな

【0016】本発明に係る光ディスクスタンパの製造方 法は、前記有機フッ素化合物からなる離型層を形成する 工程において、水のイオンビーム照射によって前記酸化 30 膜表面を活性化した後に、有機フッ素化合物を蒸着処理 することを特徴とする。前記の構成によれば、離型膜を 形成する際のシラン化合物の吸着活性点が高密度で形成 され、離型効果に優れ耐久性の高いスタンパが可能にな

【0017】本発明に係る光ディスクスタンパの製造方 法は、前記導体化膜を構成する酸化膜がCェ、O」であ って、前記酸化膜Cr、O、の表面を加熱しながらUV 照射した後に、有機フッ素化合物を化学吸着処理すると とを特徴とする。前記の構成によれば、表面により緻密 40 なCr酸化膜の形成が可能になる。

[0018] 本発明に係る光ディスクスタンパの製造方 法は、前記酸化膜Cr、O,の表面を赤外線照射により 加熱することを特徴とする。前記の構成によれば、直接 加熱されるヒータ部分が無いゆえ、パーティクルの発生 によるスタンパの欠陥発生が排除される。

【0019】本発明に係る光ディスクスタンパの製造用 治具は、前記の光ディスクスタンパの製造方法の有機フ ッ素化合物からなる離型層を形成する工程に用いる治具 であって、スタンパを裏面と表面の外周部とで支持し、

特開平10-308040 6

に有機フッ素化合物吸着処理液を供給して、スタンパ表 面のみに該有機フッ素化合物処理を行うことを特徴とす る。前記の構成によれば、酸を含む処理液にスタンパの 裏面をさらして腐食させることなく、スタンパ表面にの み離型層を形成させることが可能になる。

【0020】本発明に係る光ディスク成型用スタンパ は、前記製造方法により製造されたことを特徴とする。 前記の構成によれば、表面に配向された離型膜の-CF ,基が他の物質の付着を妨げ、よって良好な離型性が実 現される。このようにして離型不良に伴う製品不良率が 10 減少し、かつ耐用寿命の長いスタンパが実現される。

[0021] 本発明に係る光ディスクは、前記の光ディ スク成型用スタンパを用いて製造されたことを特徴とす る。前記の構成によれば、離型性の良好なスタンパで成 形されることにより、離型時の信号ピット形状の変形が 避けられ、原盤の信号ピット形状を忠実に転写した表面 形状の光ディスクが得られる。

[0022]

[発明の実施の形態] 本発明では、前記のような従来法 の問題点を解決するために、電鋳の際の陰極となる導体 化膜を、その表面に有機フッ素化合物がシロキサン結合 によって強固にかつ高蜜度に結合されうるための酸化膜 と、これに隣接する金属導体化膜の少なくとも2層構造 とし、原盤からスタンパを剥離した後に、該酸化膜上に 前記有機フッ素化合物からなる離型層を形成することを 特徴とする。とのような製造方法によれば、十分な厚さ と機械的強度及び密着性を有する酸化膜の上に有機フッ 素化合物からなる離型層を形成でき、しかも原盤の信号 ピット形状等を極めて忠実に反転したスタンパを得るこ とができる。以下、実施形態に基づいて本発明の詳細を 30 説明する。

【0023】実施例1

図1は、本発明によるスタンパの製造方法を説明する模 式断面図である。同図に示されるように、ガラス基板 1 上にフォトレジスト膜2を塗布形成し、レーザ露光、現 像等の工程を経て、フォトレジスト膜2上に微細な凹凸 バターンを有した光ディスク原盤3を作成する。次にこ の光ディスク原盤3の表面に、反応性スパッタ法により Ni酸化物7 (NiO)を100nm形成し、続いてN iの金属導体化膜4を50nm形成した。このとき、酸 素ガスの分圧を徐々に減らしながら成膜を行い、Ni酸 化物7と金属導体化膜4とに明確な界面が存在しないよ うにした。

【0024】次に、金属導体化膜4を陰極としてNi電 鋳を行い、さらにフォトレジスト膜2とNi酸化物7と の界面からこれを剥離し、スタンパ6を得た。

【0025】次に、スタンパ6上にわずかに存在するフ ォトレジスト膜2の残留成分を除去するために、図示し ていないUVアッシャー装置によりスタンパ表面をオゾ ンあるいは活性酸素下にさらし、表面の残留有機物を除 50 るような離型不良は発生しなかった(メタクリル樹脂、

去した。

[0026]図2は、本発明によるスタンパの製造方法 を説明する全体構成図である。前記に続き、図2に示さ れるように、スタンパ6を真空チャンパー11導入し、 真空引きした後に水のイオンビームを照射し、スタンパ 6表面を活性化した。とのときのイオン照射条件は、イ オン照射量 1×10¹¹ ions/cm²、加速電圧30 0 v とした。水のイオンビーム照射により、スタンパの 酸化膜7の表面に、化学結合によって強固に結合した水 酸基即ち次工程における有機フッ素化合物の化学吸着活 性点を高密度に形成することができる。

【0027】次に、イオンビームの照射を止めて、真空 蒸着法により有機フッ素化合物の離型層を形成した。即 ち、無機物粉末やスチールウール等の金属魂にフルオロ アルキルシランSiX(OR), (Xはフルオロアルキ ル基、ORはアルコキシ基)を固着させた蒸着ソース8 を、真空チャンバー11内で電子ビーム加熱し、対向す るスタンパ6にシランを蒸着した。より具体的には、フ ルオロアルキルシランCF, (CF,), CH, CH, Si(OCH₁), を用いた。

[0028] その他に、CF, (CF,), CH, CH , Si (OCH,), CF, (CF,), CH, CH , Si (OCH,), CF, (CF,), CH, CH 、Si(OC, H,),等のアルコキシシラン、クロル 基やシアノ基、イソシアナト基、アミノ基等の官能基Y を有するフルオロアルキルシランSiX。Yュ、等を用 いることができる。これらのフルオロアルキルシラン は、無機物表面の水酸基と化学反応を起とし、シロキサ ン結合〇-Si-〇により強固に無機物表面に結合を形 成する。

[0029]以上のようにして得られたスタンパの断面 模式図を図3に示す。同図では、便宜上、離型層12の 部分を特に拡大して描いているが、実際の離型層12の 厚さは数 n mのオーダーである。また、酸化膜7と金属 導体化膜4の界面は傾斜組成になっているが、図では簡 略して2層に描いてある。

【0030】本発明による光ディスクスタンパは、表面 に-CF, 基が配向した離型層12を有している。-C F,基のようなフルオロカーボンは、フッ素の高い電気 陰性度のためC-F間の結合エネルギーが大きく、化学 的に極めて安定である。即ち、他の物質が化学結合的に 付着することがない。また、このような分子内の強い結 合に対して、分子間では極めて弱い相互作用しか持たな いため、他の物質の物理的吸着や付着がなく、良好な潤 滑性を発現する。このような表面特性から、本発明によ る光ディスクスタンパは、極めて良好な離型性を有す

【0031】このスタンバを用いて光ディスクの射出成 形を行ったところ、およそ10万枚の成形まで問題とな

.

シリンダ温度260℃、金型温度60℃)。

[0032] 実施例2

実施例1において、光ディスク原盤の表面に、反応性スパッタ法によりCr酸化物(Cr2O,)を100nm形成し、続けてCr金属導体化膜を20nm、さらに続けてNi金属導体化膜を30nm形成した。実施例1と同様、Cr酸化膜とCr金属導体化膜の界面は傾斜組成にしている。電鋳後、フォトレジスト膜とCr酸化膜の界面からこれを剥離し、スタンパを得た。

【0033】次に、とのスタンパをUVアッシャー装置 10で清浄化する際、赤外線加熱により200℃に加熱しながら2時間の処理を行った。アッシャー工程でUVを照射しながらスタンパを加熱することで、アニール効果とオゾンあるいは活性酸素の酸化作用によって、表面により級密な酸化膜が形成される。緻密な酸化膜によって、より高密度のフッ素化合物吸着活性点が得られ、同時に次のクロルシラン湿式吸着処理工程で発生する塩酸に対するスタンパの耐食性を問題ないレベルにまで改善することができる。また、赤外線を用いた加熱方法は、ヒータのような直接加熱部を持たないのでパーティクルの発 20生が無く、スタンパへの点欠陥等を招くことがない。

[0034]次に、有機フッ素化合物離型層の形成を図4に示す治具を用いて行った。スタンパ6は、例えばテフロン製の処理治具(側治具15、押さえ板13)で裏面より支持されており、信号ピットを有するスタンパ表面側にシラン処理液16を保持するための液溜まり空間を側治具15とで形成している。スタンパ6の裏面は電鋳Niが露出しているため、シラン処理液16にさらされることの無いよう0リング14でシールがなされている。

【0035】加熱UV照射下で、スタンバを図4のような治具に取付けた後、窒素置換雰囲気でシラン処理液を液溜まり空間に供給した。シラン処理液は、フルオロアルキルクロルシランCF、(CF、)、CH、CH、SiCl、、10mMをパーフルオロヘキサンに希釈したものを用いた。浸漬時間は室温で1時間とした。次に、余分に物理吸着したシランを除去するために、パーフルオロヘキサンでスタンバ6を洗浄し、さらに純水中で軽く揺動洗浄した後に、窒素ブローで乾燥させた。このようにして得られたスタンパは、実施例1と同様に良好な離型性を有した。

【0036】本実施例ではクロルシランを用いたが、前述のアルコキシシランを使用することもできる。との場合、加水分解触媒として塩酸や酢酸等の酸を添加した処理溶液を用い、乾燥後、150℃で1時間の焼成を行う。とのようなあらかじめ酸を含む処理プロセスに対しても、本方法によれば安定的に離型層を形成することができる。

[0037]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の請求項 1

に係る光ディスクスタンパの製造方法では、原盤から離型したときのスタンパ表面に酸化膜が形成されているため、アルコキシ基、クロル基、シアノ基、イソシアナト基、アミノ基等の官能基Yを有するフルオロアルキルシランSiX。Y,。を高密度かつ強固に化学吸着(共有結合)させて良好な離型層をスタンパ最表面に形成さることができる。しかも、該酸化膜はあらかじめ形成されているため、従来の原盤からスタンパを離型した後にこれらを成膜するものに比べ、原盤のビット形状をより忠実に反転しており、信号品質の良好なスタンパをえることができた。本製造方法によるスタンパにより、離型不良に伴う製品不良率を減らし、同時に樹脂付着物等によるスタンパの耐用寿命を大幅に延ばすことができた。

【0038】本発明の請求項2に係る光ディスクスタンパの製造方法では、導体化膜を構成する酸化膜の膜厚が100nm以上と十分に厚いため、酸化膜が緻密な膜構造をとり、酸化膜自身の密着性や機械的強度に優れるとともに、離型膜を形成する際のシラン化合物の吸着活性点を高密度で与えることが可能になる。

【0039】本発明の請求項3に係る光ディスクスタンパの製造方法では、該酸化膜を構成する金属元素とこれに隣接する金属導体化膜の金属元素とが同一元素であり、さらに両者の界面が傾斜組成となっているので、酸化膜の密着力が高く、したがってこれらの境界部分からの脱落等がなく、離型効果の耐久性が高いスタンパを得ることができる。

【0040】本発明の請求項4に係る光ディスクスタンパの製造方法では、導体化膜を構成する酸化膜がCr、O,なので、次のUVアッシャー工程でのオゾンあるいは活性酸素の酸化作用によって、より緻密な表面酸化層が形成されるため、シラン化合物を高密度かつ強固に形成でき、離型効果とその耐久性の高いスタンパを提供することができる。また、2層構造となっている金属導体化膜のうち、Crは前記酸化膜Cr、O,と良好な密着性を有し、Niはその下層のCrとの良好な密着性を有し、かつ電鋳の際の陰極として有害な酸化膜が残りにくいため、電鋳層との良好な密着性を与える。したがって、これらの境界部分からの脱落等がなく、よって離型効果の耐久性が高いスタンパを得ることができる。

【0041】本発明の請求項5に係る光ディスクスタンパの製造方法では、水のイオンビーム照射によって酸化膜表面を活性化するため、離型膜を形成する際のシラン化合物の吸着活性点を高密度で与えることができる。これにより、離型効果に優れ耐久性の高いスタンバを提供することができる。

【0042】本発明の請求項6に係る光ディスクスタンパの製造方法では、導体化膜を構成する酸化膜がCr。O,であって、該酸化膜上への有機ファ素化合物の化学吸着処理にあたり、Cr、O,の表面を加熱しながらUV照射するため、表面により緻密な酸化膜が形成され

10

る。一般に、反応性スパッタ法に限らず、成膜したままの薄膜は多くの欠陥を含むため、そのままでは酸等に侵されやすいが、本方法によれば、加熱によるアニール効果とオゾンあるいは活性酸素による酸化作用によって、スタンパ表面に非常に緻密なCr酸化物が形成される。これにより、クロルシランのような反応過程で酸を発生するようなシランや、アルコキシシランのようなあらかじめ加水分解触媒として塩酸や酢酸等の酸を添加して用いるシランに対して、真空成膜法に比べてより安価な湿式プロセスが展開でき、しかも安定的に離型膜を形成することができる。

[0043] 本発明の請求項7に係る光ディスクスタンパの製造方法では、導体化膜を構成する酸化膜Cr20,の加熱を赤外線照射により行うため、直接加熱されるヒータ部分が無く、パーティクルの発生によるスタンパの欠陥発生を排除できる。また、ミラー等の光学系を用いて、既存のUVアッシャー装置に外部から容易にエネルギーを投入することができる。

[0044]本発明の請求項8に係る光ディスクスタンパの製造治具は、スタンパを裏面と表面の外周部とで支 20持し、スタンパ表面と該外周部支持治具とで形成される空間にのみシラン吸着処理液を供給するため、酸を含む処理液にスタンパの裏面をさらして腐食させることができる。

【0045】本発明の請求項9に係る光ディスクスタン 3 パは、表面に-CF,基が配向した離型膜を有している 4 から、他の物質が化学的及び物理的に強固に付着するこ 5 とがなく、極めて良好な離型性を実現できる。しかも、 6 従来の原盤からスタンパを離型した後にこれらを成膜し 30 7 たものに比べ、原盤のビット形状をより忠実に反転して*

* おり、良好な信号品質を有する。本発明によるスタンパ により、離型不良に伴う製品不良率を減らし、同時に樹 脂等の付着物を排除することによってスタンパの耐用寿 命を大幅に延ばすことが可能になる。

【0046】本発明の請求項10に係る光ディスクは、 離型性の良好なスタンパにより成形されているため、離 型時に信号ピット形状等が変化することが無く、したが って光ディスク原盤の信号ピット形状等を極めて忠実に 転写した表面形状が得られるため、従来には無い安定し た再生信号品質を有する光ディスクが得られるという効 果を奏する。

【図面の簡単な説明】

[図1]本発明によるスタンパの製造方法を説明する模式断面図である。

[図2]本発明によるスタンパの製造方法を説明する全体構成図である。

[図3]本発明によるスタンパの一実施形態の模式断面 図である。

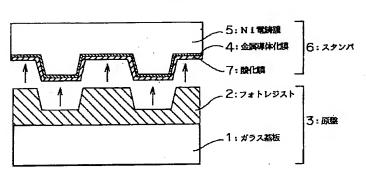
[図4] 本発明によるスタンパのシラン処理治具の一実 施形態の模式断面図である。

【図5】従来のスタンパの製造方法を説明する断面図である。

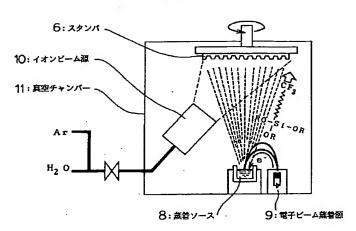
【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 フォトレジスト
- 3 原盤
- 4 金属導体化膜
- 5 ニッケル電鋳膜
- 6 スタンパ
- 7 酸化膜

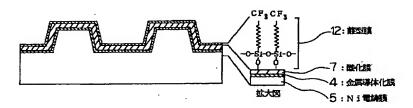
【図1】



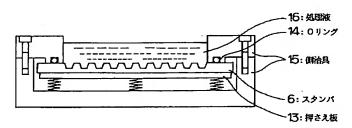




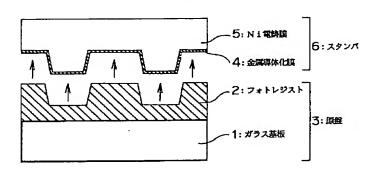
【図3】



【図4】



【図5】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: __

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.